

ワサビの茎頂培養による大量増殖法

山田員人、春木和久

摘要

本報告はワサビについて茎頂培養のための、外植体の無菌培養、シュートの形成、増殖及び発根の条件を明らかにし、大量増殖技術を開発したものである。

1. 外植体の表面殺菌は次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素 2%液が有効であった。
2. 外植体の無菌培養はハウスなどで清浄栽培した株の花茎腋芽がよかった。
3. 培地に添加する植物ホルモンとその濃度は、シュートの形成には BA0.05mg/L、発根には NAA の 0.05mg/L がよかった。
4. ワサビの培養温度は 20 度Cか、それよりやや低いところ、照度は 1,000Lx の 8 時間日長でよかった。
5. 増殖は、シュートを分割することにより可能で、2 葉柄分割を基準とすると、理論的には 1 個の腋芽から年間 6,500?59,000 本に増殖できる。